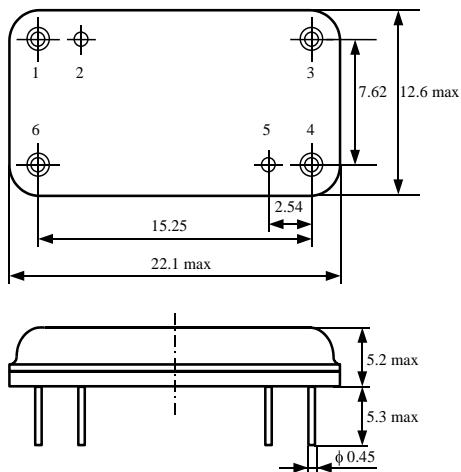
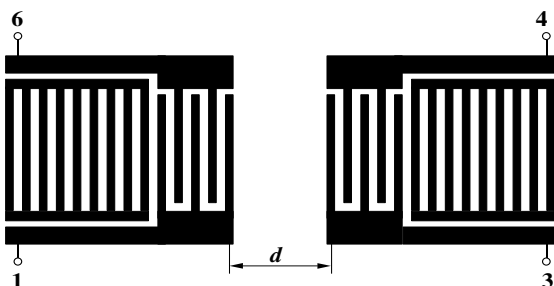


OBUDOWA

Metalowa DIP - 14



Układ wyprowadzeń



- 1 - wejście łączone z masą układu
- 2 - masa układu
- 3 - wyjście łączone z masą układu
- 4 - wyjście
- 5 - masa układu
- 6 - wejście

WARUNKI POMIARU

- temperatura otoczenia : 23°C
- impedancja sterująca : 50 Ω
- impedancja obciążenia : 50 Ω

REZONATOR CZWÓRNIKOWY

Parametr	Ozn.	Min.	Typ.	Max.	Jedn.
Częstotliwość rezonansowa	f_0	-	~196,6	-	MHz
Tłumienność wtrąceniowa	A_0	-	12	15	dB
Dobroć bez obciążenia	Q_U	15 000	20 000	-	-
Dobroć z obciążeniem $Z=50\Omega$	Q_L	11 000	14 000	-	-
Rezystancja dynamiczna	R_1	-	290	-	Ω
Indukcyjność dynamiczna	L_1	-	4 370	-	μH
Pojemność dynamiczna	C_1	-	0,15	-	f F
Pojemność statyczna	C_0	-	3,1	3,2	pF
Przesunięcie fazy	φ	-	180	-	deg
Odstęp między przetwornikami	d	-	4,0	-	mm
Temp. kompensacji	T_0	-	~20	-	°C
Temp. wsp. częst.	TWCz	-	0,032	-	ppm/°C ²
Materiał podłoża	Kwarc STX				

CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA

